

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**تکنیک پالس**

(بخش پنجم)

**استاد سادات نوری**

تهیه و تنظیم:

***www.tbi-net.com***

حال اگر  $V_o = V_{max}$  باشد ورودی را هم نشیم :

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_{omax}}{R_f}$$

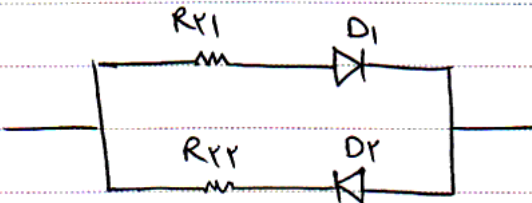
در حالت  $V_- = V_+ = 0$  ورودی

$$LTP = \frac{-R_1}{R_f} V_{omax}$$

بنابراین اگر در خروجی از ورودی زری استفاده کنیم

$$\begin{cases} V_{omax} = V_{Z_1} + V \\ V_{omin} = -V_{Z_2} - V \end{cases}$$

تا  $LTP = -UTP$  بنابراین  $UTP$  و  $LTP$  از تقو اندازه برابرند برای اینکه هم برابر باشند



می توان برای  $R_2$  از یک مقاومت دیگر استفاده کرد :

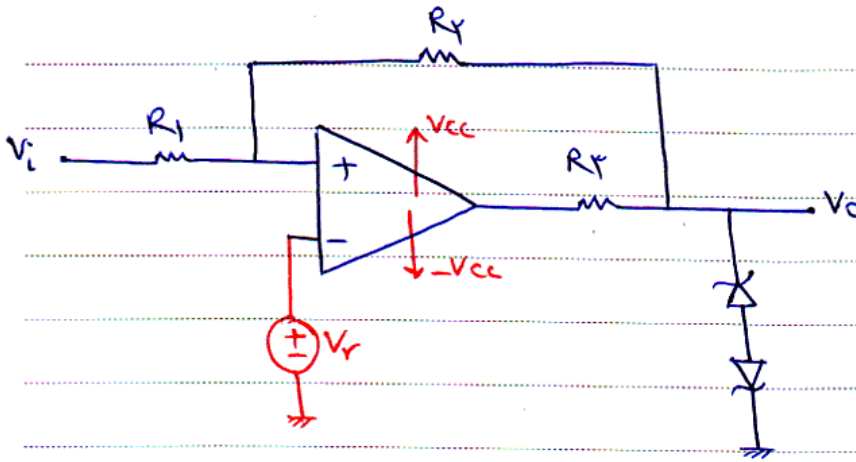
$$LTP = \frac{-R_1}{R_{f2}} V_{omax} \quad \text{و} \quad UTP = \frac{-R_1}{R_{f1}} V_{omin}$$

می توان برای این پهنای باند  $op-Amp$  را به یک دست درج  $set\ point$  وصل کرد

$$\begin{cases} V_o = V_{omin} \\ Kcl : \frac{V_i - V_r}{R_1} = \frac{V_r - V_{omin}}{R_f} \\ UTP = \frac{R_1}{R_f} (V_r - V_{omin}) + V_r \\ LTP = \frac{R_1}{R_f} (V_r - V_{omax}) + V_r \end{cases}$$

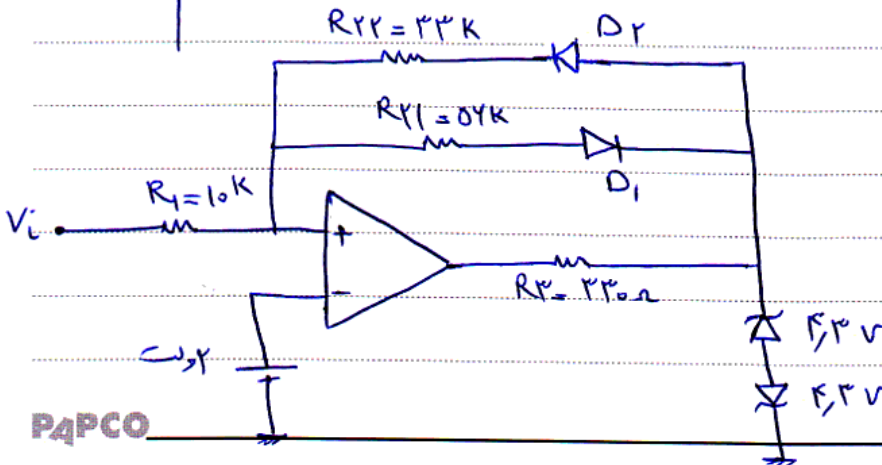
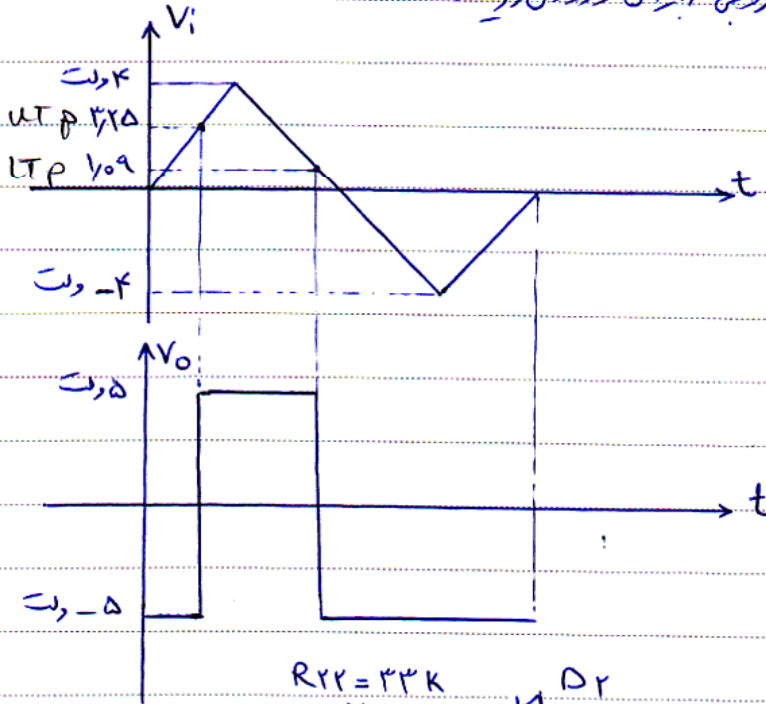
حالت قطری

107



نشان در مدار عمل زیر شرطیست که همیشه نقاط  $UTP$  ،  $LTP$

رسم مقعر شکسته است و رسم دیگر خروجی را برای ورودی در

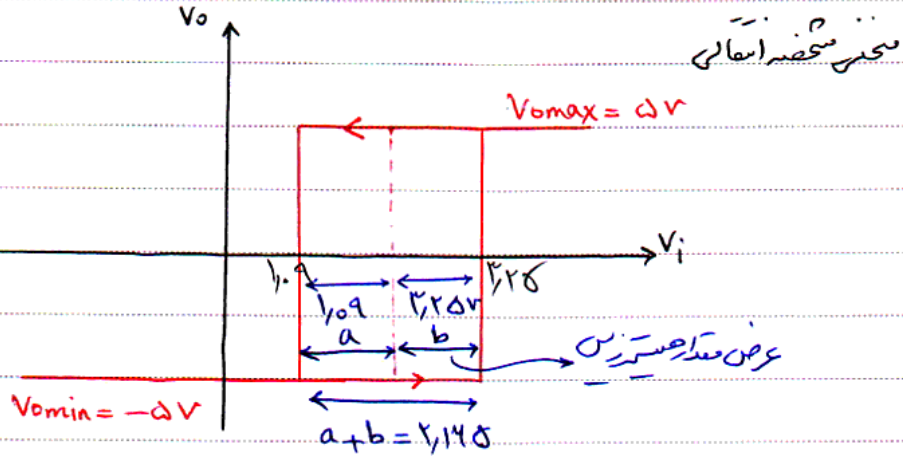


non inverting

PAPCO

$$LTP = \frac{R_1}{R_{T1}} (V_r - V_{omax}) + V_r = \frac{10}{22K} (V - \Delta V) + V = 1.09 V$$

$$UTP = \frac{R_1}{R_{T1}} (V_r - V_{omin}) + V_r = \frac{10K}{\Delta V} (V + \Delta V) + V = 3.25 V$$

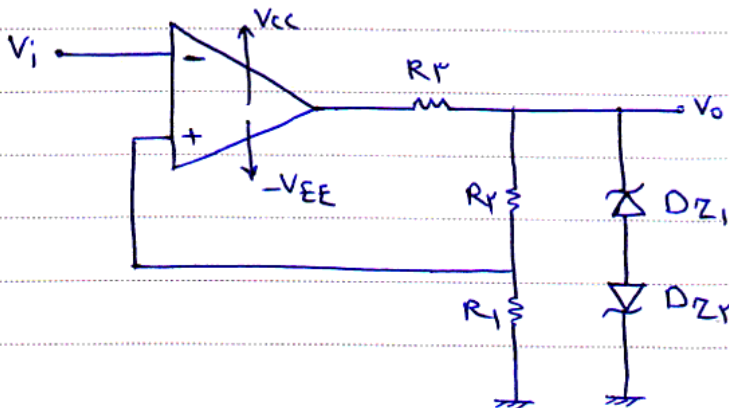


$$\begin{cases} V_{omax} = V_r + \Delta V = \Delta V \\ V_{omin} = -V_r - \Delta V = -\Delta V \end{cases}$$

$$\frac{LTP}{V} = a = \frac{R_1}{R_{T1}} (V_r - V_{omax}) + \frac{V_r}{V} = \frac{10}{44} (V - \Delta V) + 1 = 1.09$$

$$b = \frac{UTP}{V} = 3.25$$

مدار استیجی پهن باند و غیره؟



$V_- < V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omax}$  در این مدار اگر  $V_o = V_{omax}$

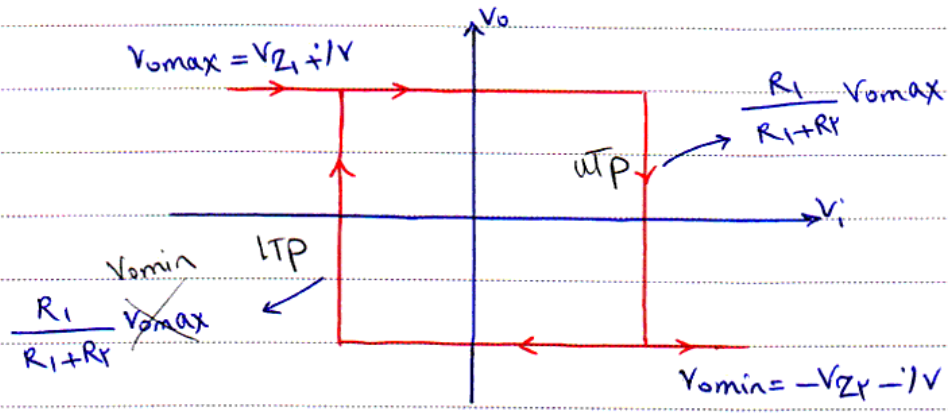
$V_- = V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omax} = UTP$  در ورودی برای بیش از  $V_-$  زیاد نمی شود تا انجام

$V_o = V_{omin}$  در این مدار  $UTP$  زیرا که بود خروجی را به اشباع منفی می رود

$V_- = V_+ > V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omin}$  اگر  $V_o = V_{omin}$

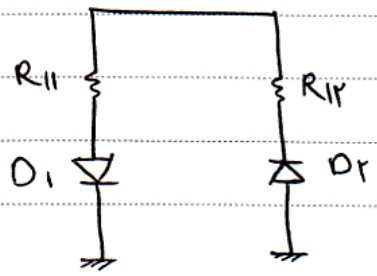
$V_- = V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{omin} = LTP$  در ورودی برای بیش از  $V_+$  نمی آید

$V_o = V_{omax}$  در ورودی از این مدار کم تر نمی خواهد شد  $V_- < V_+$



\* در این مدار هم  $LTP = -UTP$  است بنابراین برای تفاوت بودن  $UTP$  و  $LTP$  کافی است به ازای

$R_1$  معادله را کم کرد



بعضی سوال (برای فراوانی)

$$\left\{ \begin{array}{l} LTP = -3 \text{ ولت} , uTP = 2 \text{ ولت} \\ V_{CC} = 10 \text{ ولت} \\ V_{omax} = |V_{omin}| = 5,3 \text{ ولت} \\ I_{mA} < I_Z < 10 \text{ mA} \end{array} \right.$$

$$LTP = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_f} V_{omin} \rightarrow \text{طولت مثبت روی}$$

$$-3 = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_f} (-5,3)$$

$$3R_{12} + 3R_f = 5,3 R_{12} \rightarrow \boxed{R_{12} = 1,3 R_f}$$

$$uTP = \frac{R_{11}}{R_{11} + R_f} V_{omax} \rightarrow \text{درجهت روی}$$

$$2 = \frac{R_{11}}{R_{11} + R_f} (5,3) \rightarrow R_{11} = 1,4 R_f$$

$$\left. \begin{array}{l} R_f = 10^k \\ R_{12} = 13 \cong 12K \\ R_{11} \cong 14K \end{array} \right\} \text{بسیار}$$

$$V_{omax} = V_{Z1} + 1V = 5,3 \rightarrow V_{Z1} = 4,3 V$$

$$V_{omin} = -V_{Z2} - 1V = -5,3 \rightarrow V_{Z2} = 4,3 V$$

$$2 < \frac{V_{CC} - V_{omax}}{R_f} - \frac{V_{omax}}{R_f + R_{11}} < 10$$

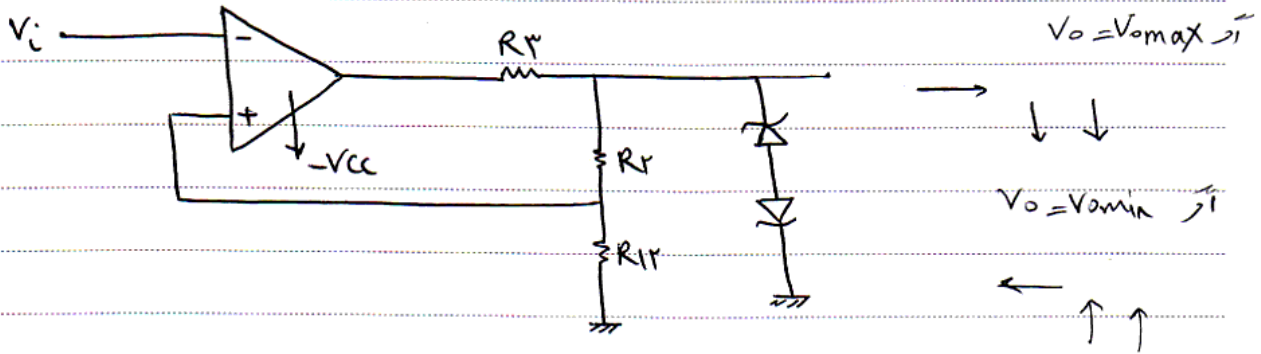
$$2 < \frac{10 - 5,3}{R_f} - \frac{5,3}{10,4} < 10$$

$$\boxed{1,4 R_f < R_f < 14,4 K \Omega} \quad \textcircled{1}$$

در  $V_o = V_{omin}$  اگر

$$I_{mA} < \frac{+V_{cc} + V_{omin}}{R_f} + \frac{V_{omin}}{R_{f2} + R_f} < 10mA$$

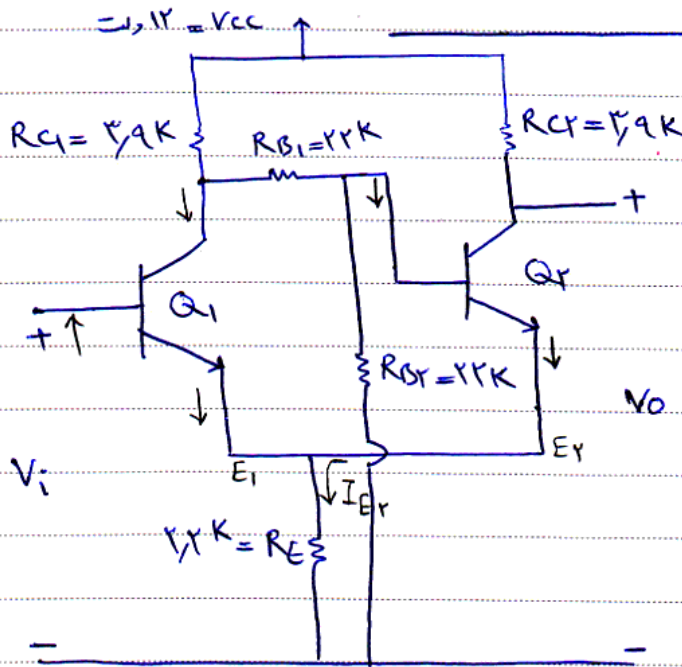
$$I < \frac{10 - \Delta I_f}{R_f} - \frac{\Delta I_f}{R_f} < 10 \rightarrow \boxed{\frac{1}{4}K < R_f < \frac{1}{9}K} \text{ (P)}$$



در  $V_o = V_{omin}$  در  $KCl$  :  $I_z = \frac{V_{omin} - (-V_{cc})}{R_f} + \frac{V_{omin}}{R_f + R_{f2}}$

$$\boxed{\frac{1}{4}K < R_f < \frac{1}{9}K}$$

از استرک در محدودی (P) و (P)



در الاستیت تریا را از استور:

نات در مدارش قابل مطلوبیت

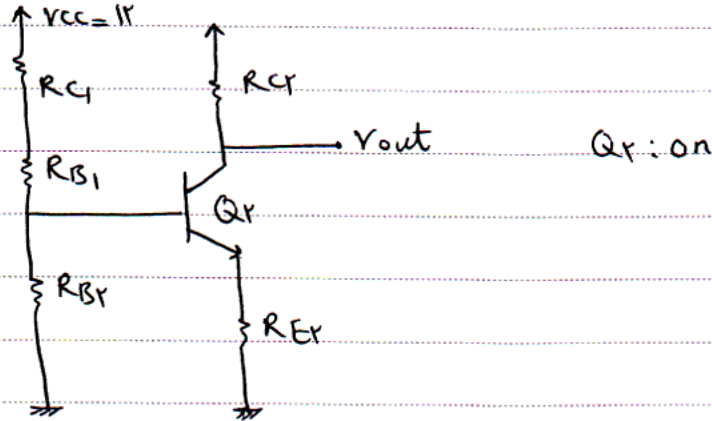
رسم مختصر مشخصه استاتی مدار، محاسبه

تپ و تپ و خروجی عملکرد آن

$$\left. \begin{array}{l} Q_1 \\ Q_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} h_{femin} = 100 \\ V_{BE} = 1V \\ V_{\gamma} = 15 \text{ دت} \end{array}$$

حسب  $\beta$ ،  $\beta_{min}$  در تویست

حل  
 ورودی دردی کم باشد  $Q_1: off$  و در نقطه سایل برآزست  $Q_2$  خواهد بود

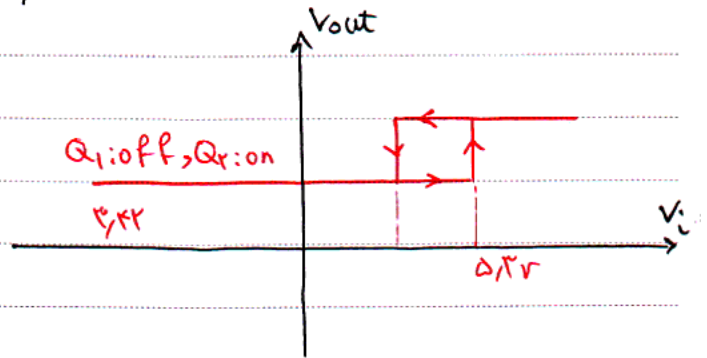


$$V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2} + R_C} \cdot V_{CC} = 5.15 \text{ V}$$

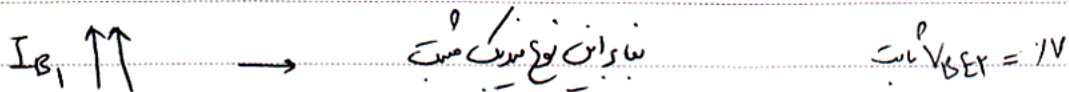
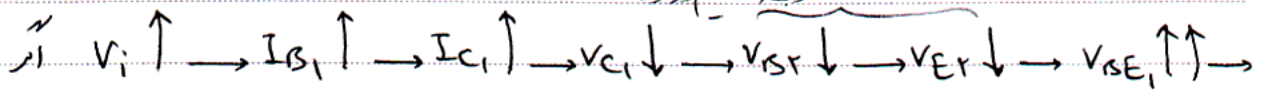
$$V_{E1} = V_{E2} = V_{B2} - V_{BE2} = 5.15 - 1 \text{ V} = 4.15 \text{ V}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} \approx \frac{V_{E2}}{R_E} = \frac{4.15}{12} \approx 1.2 \text{ mA}$$

$$V_{out} = V_{CC} - R_{C2} I_{C2} = 2.22 \text{ V}$$



در ورودی راسته یخ زیاد کنیم  $Q_1$  در آستانه نبردن سایل مرکزی سرد





در حالت اول  $V_{BE1} = V_{BE} = 0.7V \rightarrow V_{B1} - V_{E1} = 0.7V$

$V_{E1} = V_{E2} \quad V_{E1} - I_{E1} R_E = 0.7V \rightarrow V_{E1} = I_{E1} R_E + 0.7V \rightarrow Q_1: on$   
 $V_{B1} = V_{E1} \rightarrow Q_2: off$   
 $\rightarrow V_o = V_{CC} = 12V$

$V_{BE1}$  کم من بود و  $Q_2$  خاموش من بود.

$V_{out} = V_{CC} - R_{C1} I_{C1} = 12 - 2.2V$

در  $Q_1$  وصل و  $Q_2$  خاموش بود،  $V_{E1}$  را کاهش دهیم،  $Q_2$  را خاموش کنیم  
 $V_{BE1} = 0.7V = V_{BE}$

②  $V_{E1} \downarrow \rightarrow V_{BE1} \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow \rightarrow I_{C2} \uparrow \rightarrow V_o \downarrow$

①  $V_{E1} \downarrow \rightarrow V_{B1} \downarrow \rightarrow V_{E1} \downarrow \rightarrow V_{BE1} \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow \rightarrow I_{C2} \uparrow \rightarrow I_{E1} \uparrow \rightarrow V_{E1} \uparrow$

$\rightarrow V_{BE1} \downarrow \downarrow \rightarrow Q_1: off$

فیدبک مثبت در مدار هنگام کاهش  $V_{E1}$ .

$C_1$  در  $10k\Omega$  ،  $\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}} = I_{C1} + \frac{V_{C1} - 0}{R_{B1} + R_{B2}}$  ①

وقتی  $Q_2$  خاموش است و  $Q_1$  روشن است،  $V_{E1}$  را کاهش دهیم.

$I_{C1} = I_{E1} = \frac{V_{B1} - V_{BE1}}{R_E} = \frac{(V_{B1}) - 0.7V}{2.2}$  ②

$\rightarrow V_{B1} - V_{BE1} - R_E I_{C1} = 0$

$\frac{12 - V_{C1}}{2.2} = \frac{V_{C1} - 0.7V}{2.2} + \frac{V_{C1}}{44}$

① جانمایی ترانزیستور  
 ② تنظیم

Subject:

109

Year. Month. Date. ( )

$$\frac{12}{29} - \frac{V_{C1}}{29} = \frac{V_i}{22} - \frac{1V}{22} + \frac{V_{C1}}{44}$$

$$\frac{22}{29} - \frac{V_i}{29} = \frac{V_{C1}}{29} + \frac{V_{C1}}{44} \rightarrow \boxed{V_{C1} = 12,18 - 1,43 V_i}$$

$$V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} \cdot V_{C1} = 4,09 - 1,11 V_i$$

$$V_{B2} - V_{E2} = 10$$

$$V_{B2} = 10 \rightarrow 4,09 - 1,11 V_i - (V_i - 1V) = 10V$$

$$V_{E2} = V_{E1} = 1V$$

$$4,09 = 1,11 V_i$$

$$\rightarrow \boxed{V_i = 3,68 \approx 3,7}$$

0,77

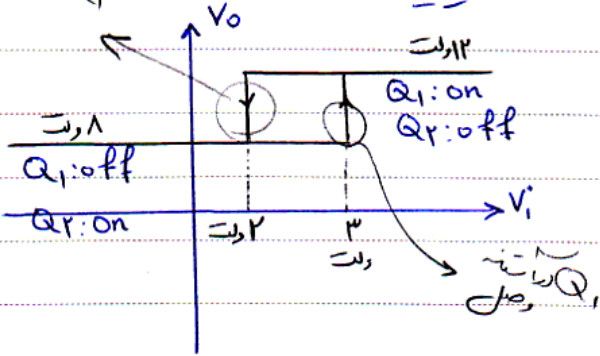
$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1: \text{on} \\ Q_2: \text{off} \end{array} \right. \quad V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{C1}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1: \text{off} \\ Q_2: \text{on} \end{array} \right. \quad V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1} + R_{C1}} \times V_{CC}$$

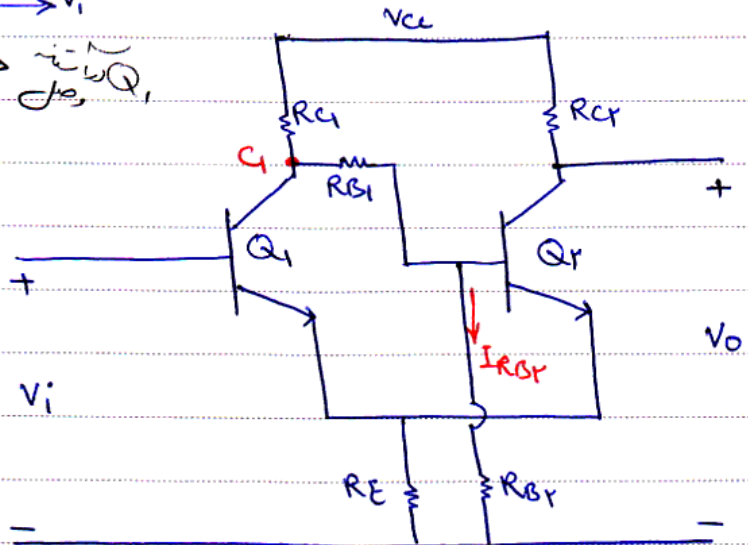
م: طراحی مدار استیج و پهنای باند آن

مداری مطابق شکل زیر طراحی کنید که دارای مشخصه انتقالی زیر باشد و حداقل مقاومت بار  $10k\Omega$  در خروجی مدار را بتواند تحمیل کند.

مداری که بتواند بین این طراحی و مشخصه انتقالی مدار استیج را ارتباط دهد طراحی کنید:



$I_{R_{B2}} = \frac{1}{10} I_{C1}$



حل:  $R_L \parallel R_{C2} \approx R_{C2}$   
 $R_{C2} \ll R_L$

$R_{C2} < \frac{1}{10} R_L = 1k\Omega$

$\rightarrow R_{C2} = 1k\Omega$

Q<sub>1</sub> on, Q<sub>2</sub> off

$$V_o = V_{cc} - R_{C1} I_{C1} = \Lambda \text{ ولت}$$

از روی نمودار ولت  $V_{cc} = 12$

$$12 - R_{C1} I_{C1} = \Lambda \text{ ولت} \rightarrow I_{C1} = \frac{12 - \Lambda}{1} = 4 \text{ mA}$$

UTP در نقطه  $V_{BE1} = 0.7 \text{ ولت}$  ولت  $V_{B1} - V_{E1} = 0.7$

$$V_i - V_{E1} = 0.7 \rightarrow 3 - V_{E1} = 0.7 \rightarrow \boxed{V_{E1} = 2.3 \text{ ولت}}$$

با این روش:  $V_{E1} = V_{E2} = 2.3 \text{ ولت} = V_{B2} - 0.7$

$V_{B2} = 3 \text{ ولت}$  ولت  $V_{E2} = R_{E2} I_{E2} = 2.3 \text{ ولت}$  ولت  $R_{E2} = \frac{2.3}{4} = 425 \Omega$

از این مقدار  $\rightarrow 425 \Omega$

Q<sub>1</sub> on, Q<sub>2</sub> off

سازگار  $V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} V_{C1}$

قانون KCL:  $\frac{V_{cc} - V_{C1}}{R_{C1}} = I_{C1} + \frac{V_{C1}}{R_{B1} + R_{B2}}$

در این حالت  $I_{R_{B2}} = \frac{1}{10} I_{C1} = \frac{1}{10} \times 4 \text{ mA} = 0.4 \text{ mA}$

$$\frac{12 - V_{C1}}{R_{C1}} = 0.4 \text{ mA} + \frac{V_{C1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

112

$$V_{B1} = V_i = LTP = 2$$

$$V_{B1} - V_{E1} = 1V \rightarrow V_{E1} = V_{E2} = 1V$$

$$V_{BEF} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{EF} = (V_{B1}) - 1V = (V_i) - 1V = 2 - 1V = 1V$$

Q<sub>1</sub> is in active region

$$I_{C1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{1V}{40\Omega} = 19 \text{ mA}$$

$$* I_{RB1} = \frac{V_{B1}}{R_{B1}} = 19 \text{ mA}$$

$$V_{BEF} = 1.5 \text{ V} \rightarrow V_{B1} = 1.5 + V_{EF} = 1.5 + 1V = 2.5 \text{ V}$$

$$R_{B1} = \frac{V_{B1}}{I_{RB1}} = \frac{2.5}{19} \approx 10 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{12}{R_{C1}} - \frac{V_{C1}}{R_{C1}} = 19 \text{ mA} + \frac{V_{C1}}{R_{B1} + 10 \text{ k}\Omega}$$

$$\frac{12}{R_{C1}} - 19 \text{ mA} = \left( \frac{1}{R_{C1}} + \frac{1}{R_{B1} + 10} \right) V_{C1}$$

$$V_{C1} = \frac{\frac{12}{R_{C1}} - 19}{\frac{1}{R_{C1}} + \frac{1}{10 + R_{B1}}}$$

$$V_{C1} = \frac{\frac{12 - 19R_{C1}}{R_{C1}}}{\frac{10 + R_{B1} + R_{C1}}{R_{C1}(10 + R_{B1})}} = \frac{(R_{B1} + 10)(12 - 19R_{C1})}{10 + R_{B1} + R_{C1}}$$

$$V_{B1} = \frac{10}{10 + R_{B1}} \cdot \frac{(10 + R_{B1})(12 - 19R_{C1})}{10 + R_{C1} + R_{B1}} = 1.5 \text{ V}$$

$$\frac{120 - 19R_{C1}}{10 + R_{C1} + R_{B1}} = 1.5$$

$$120 - 19R_{C1} = 1.5(10 + R_{C1} + R_{B1})$$

$$120 - 19R_{C1} = 15 + 1.5R_{C1} + 1.5R_{B1}$$

$$105 = 1.5R_{C1} + 1.5R_{B1} \quad \text{①}$$

PAPCO

$$V_{B_1} = \frac{R_{B_2}}{R_{B_2} + R_{B_1} + R_{C_1}} \times V_{CC}$$

$Q_1: on, Q_2: off$

$$= \frac{10}{10 + R_{B_1} + R_{C_1}} \times 12 = 7.2 \text{ V}$$

$$12 = 7.2 + 7.2 R_{B_1} + 7.2 R_{C_1} \rightarrow 4.8 = 7.2 (R_{B_1} + R_{C_1})$$

$$\boxed{R_{B_1} + R_{C_1} = 27.5} \quad (2)$$

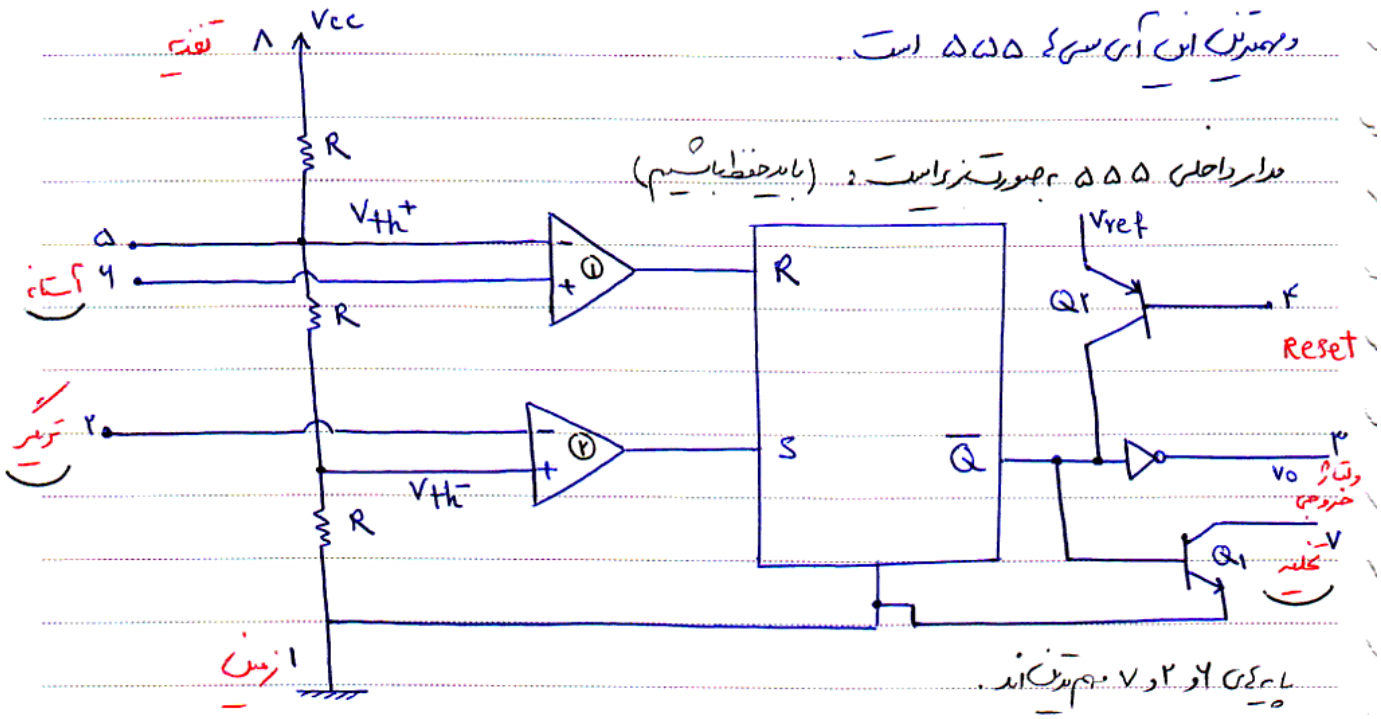
(2), (1) سے  $R_{B_1} = 10 \text{ k}\Omega$      $R_{C_1} = 2.7 \text{ k}\Omega$

فصل پنجم:

IC های زمان بیخ: این IC ها از قابلیت کشنده های و دینار کشیدن می توانند با اتصال خازن و معادله های

آن که از سولن های سری مدارات مولتی ویراتور ساخته می شوند

در جدول این آی سی که 555 است



در این مدار ابروی دینار که با پین 2 و 4 و 7 وصل نشده باشد:

$$V_{th}^+ = \frac{2}{3} V_{cc}$$

$$V_{th}^- = \frac{1}{3} V_{cc}$$

لذا خروجی پین 1 را به عنوان خروجی مقایسه تر 1 و پین 2 را به عنوان

نابراین پین 1 را به پین 2 وصل می کنند و  $V_o = high$  و  $\bar{Q} = 0$  می شود و  $Q_1$  خاموش می شود.

نکته: پایه شماره 4 به عنوان Reset است. این پایه نیز وصل شود.  $Q_2: on$  واضح خواهد شد

خوب. ولت  $V_{ref} = 2V_{BE} = 1.4$  است و  $Q_1 = \bar{Q}$  و  $V_o = high$  خواهد شد و مدار در این حالت

قرار میگیرد تا زمانی که مدارات مولتی ویرایزور پایه 4 هم به  $V_{cc}$  وصل شود. ( $Q_2: off$ )

پایه 5: این پایه ولتاژی از خروجی  $V_{th}^+ = \frac{2}{3} V_{cc}$  خواهد بود. اما برای آن که اعمال

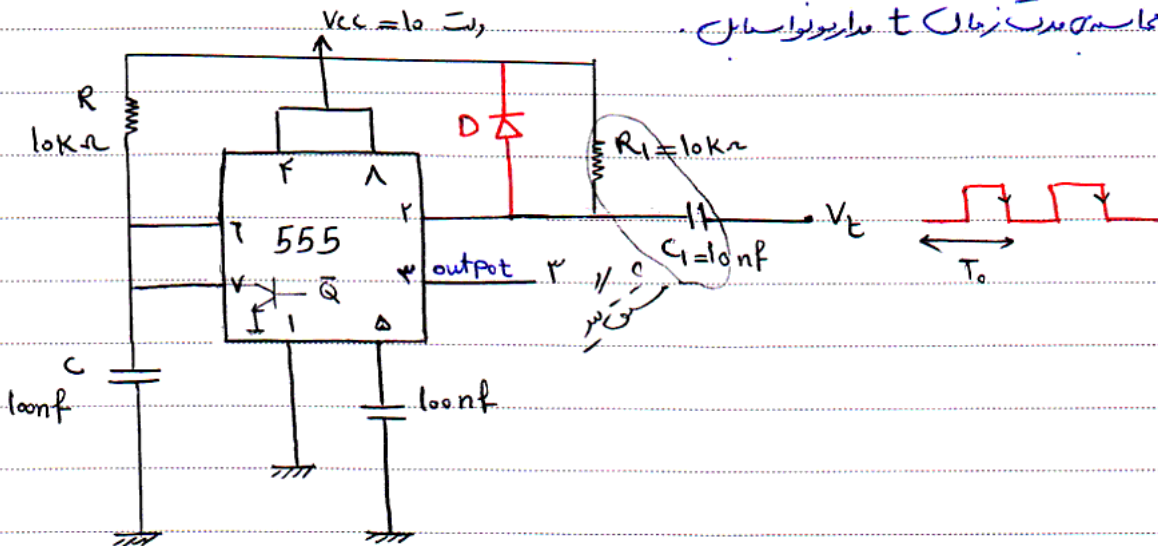
ولتاژی از خروجی  $V_{th}^+$  را تغییر داد. این کار با اهم این پایه و ولتاژی وصل کنیم. این کار با  $100nF$  نیز میسر

(برای اینکه نویز کم شود) پایه 5 را با یک پتانسیومتر در مدار در مولتی ویرایزور کرد.

نشان دهد مدار وصل نیز میسر است:

انتی: بررسی عملکرد مدار (ب) رسم شکل موج های  $V_1$ ،  $V_2$  و  $V_3$ .

چرا محاسبه مدت زمان  $t$  مدار می توانیم.



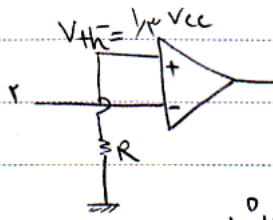


در حالت دائمی بدون اعمال پدیده خازن  $C_1$  اتصال باز می شود بنابراین  $V_Y = V_{CC}$  و  $Q_1 : off$

هر چه عقاب بر  $Q_1$  باز می آید خازن  $C$  هم اتصال باز می شود لذا  $V_Y = V_{CC}$  ، بنابراین  $Q_1$  می آید

Reset ، مدار اعمال شود  $V_O = low$  خواهد بود ،  $Q_1 = high$  و  $Q_2$  وصل می شود و خازن  $C$

را تخلیه می کند لذا در حالت دائمی  $V_Y = 0$  است



اگر  $V_Y = 1/3 V_{CC}$  اعمال می شود ،

در نتیجه  $Q_1$  تغیر می یابد ، این Set مدار اعمال شود و  $V_O = V_{CC}$  خواهد بود

$Q_1 : off$  و  $Q_2 = low$  لذا ولتاژ خازن  $C$  می تواند با ثابت زمانی  $\tau = RC$  شارژ شود و در حالت دائمی می خواهد

$V_{CC}$  برسد ، اگر  $V_Y = 1/3 V_{CC}$  برسد ، این Reset اعمال می شود و  $V_O = low$  و  $Q_2 = high$

$Q_1$  on و خازن  $C$  با فاصله تخلیه می شود و منتظر می ماند تا بار

$$T \begin{cases} V_Y(\infty) = V_{CC} \\ V_Y(0) = 0 \\ V_Y(T) = \frac{1}{3} V_{CC} \\ \tau = RC \end{cases}$$

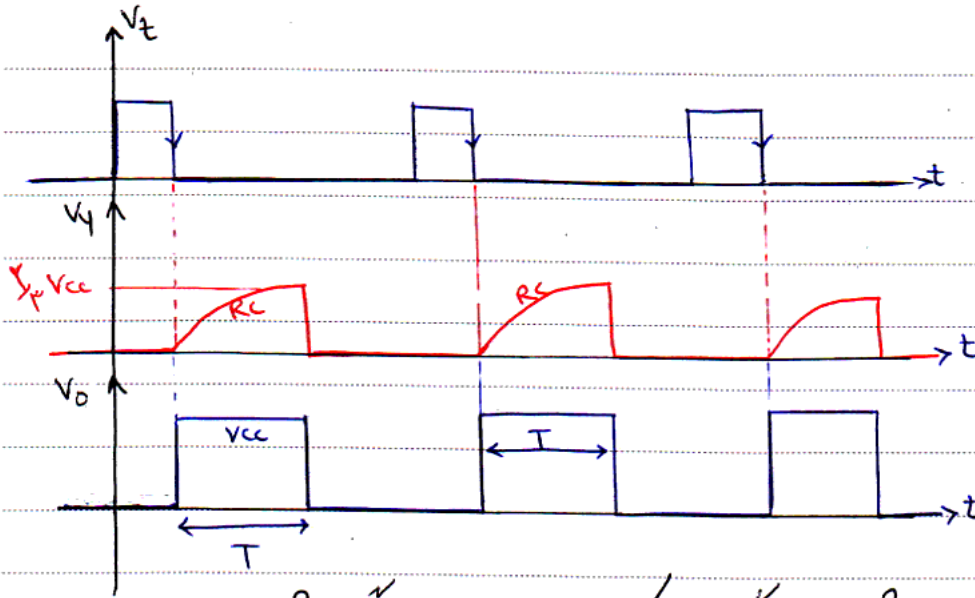
$$T = \ln 3 \cdot RC$$

این رابطه است و باید حفظ شود

این رابطه

$$= 1.1 \text{ msec}$$

رای موقت است



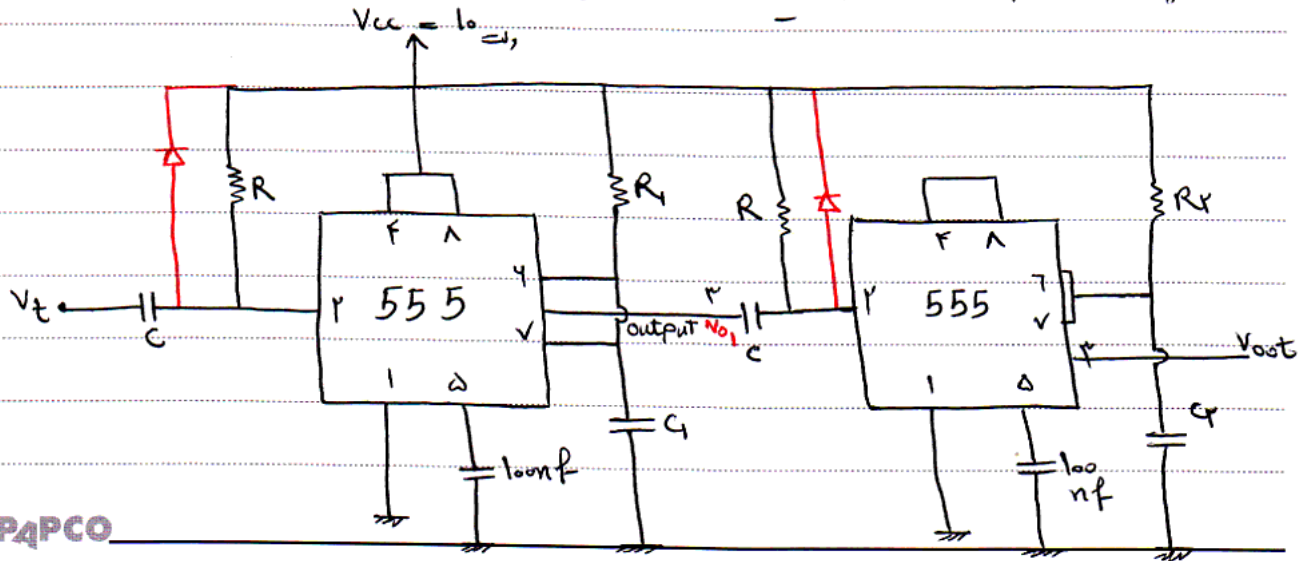
کاربرد ۵ : برای حذف لبه های مثبت و منفی و برای جلوگیری از اینکه ولتاژ  $V_y$  از  $V_{cc}$  بزرگ تر شود

حجم بار در این مدار بسیار کم است  
 رابطه زیر در نظر بگیرید  
 $R_1 C_1 = 100 \mu\text{sec} < \frac{T_{\text{min}}}{10} = \frac{T}{10} \sqrt{\quad} = 11.0 \mu\text{sec}$

در این مدار ولتاژ قابل بار را نیز از حدی پایین تر قرار داده شود

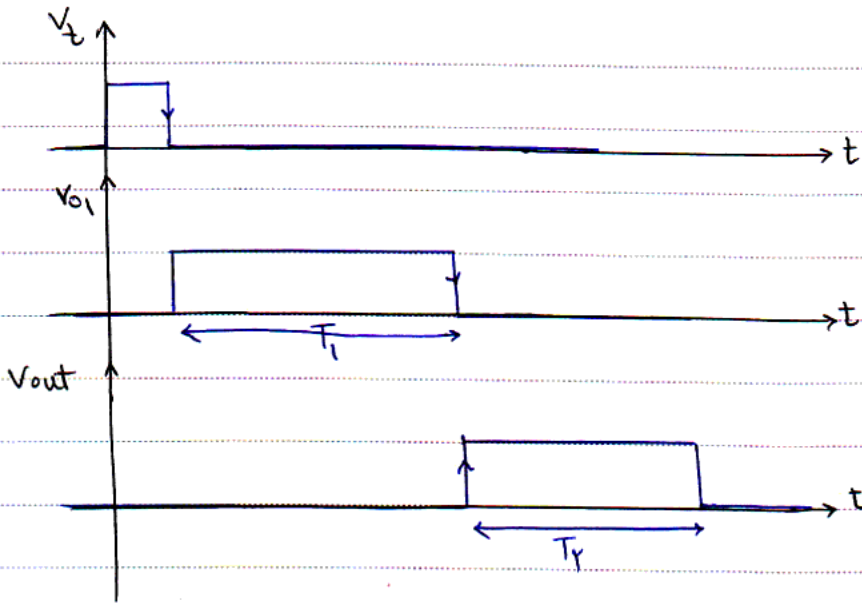
با  $R_1 C_1 < \frac{T_{\text{min}}}{10} = \frac{T}{10}$  (برای شروع سرد کردن) و  $T_0 > T$  باشد و  $T_{\text{min}} = T$

اگر چند مدار فوق الذکر را به هم بنویسیم یک مدار تایمر درستی ایجاد می شود



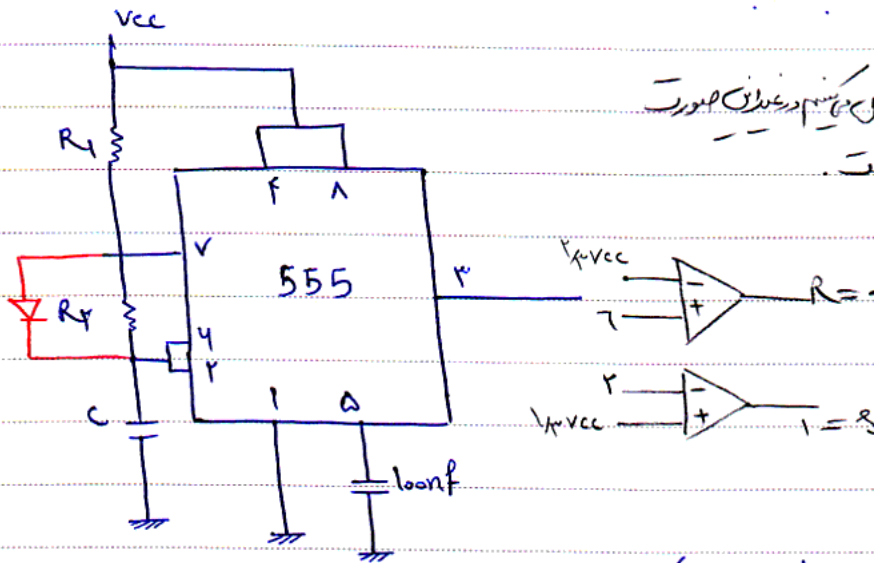
Subject:

Year. Month. Date. ( )



مدار استاین:

نظری زیر یک مدار استاین را با 555 نشان بدهد



ماهیچه 4 و 8 را هم وصل کنیم در این صورت همیشه خروجی برابر Vcc است.

در لحظه زدن Vcc خازن C اتصال کوتاه می شود.

یک بار این اتصال برقرار می شود  $V_o = V_{cc}$  خواهد بود در این حالت  $Q_1 = off$  و  $Q_2 = low$

و خازن C می تواند شارژ شود با این زمان  $C = R_1 C$  در حالت پایدار می خواهد  $V_{cc}$  برسد اما ما نمی خواهیم  $V_{cc}$

پسندیدہ ہیں Reset پر عمل آئے وہ  $V_o = low$  ،  $\bar{Q} : high$  ،  $Q : on$  بنا رہا ہے تاکہ یہ

$T_r = R_2 C$  کا مونس بن کر رہے گا  $V_o$  نکلے گا اور در حالت طے سے خواہد ہو رہا ہے خاصہ  $\frac{1}{3} V_{CC}$

پسندیدہ ہیں set پر عمل آئے وہ  $V_o = V_{CC}$  ،  $\bar{Q} = 0$  ،  $Q$  ختم ہو جائے گا

باردور  $T_1 = R_1 C$

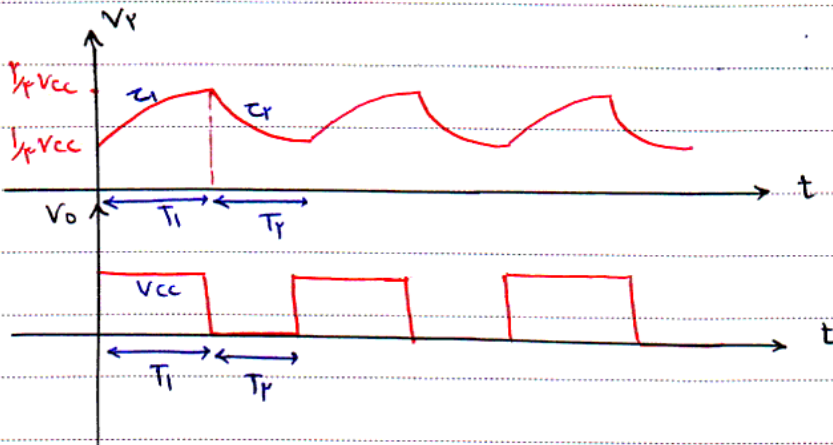
ہم باردور  $T_2 = R_2 C$  ہم باردور  $T_1 = (R_1 + R_2) \cdot C$  ہم باردور

$$T_1 : \begin{cases} V_1(\infty) = V_{CC} \\ V_2(0) = \frac{1}{3} V_{CC} \\ V_2(T_1) = \frac{2}{3} V_{CC} \end{cases} \rightarrow T_1 \approx 0.493 C_1$$

اسی در رابطہ کے ساتھ

$$T_r : \begin{cases} V_2(\infty) = 0 \\ V_2(0) = \frac{2}{3} V_{CC} \\ V_2(T_r) = \frac{1}{3} V_{CC} \end{cases} \rightarrow T_r \approx 0.493 C_r$$

میان ۳ سوال ۱/۲.  $\left. \begin{matrix} 50\% \\ 20\% \\ 10\% \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \leftarrow \text{نصف ۴} \\ \leftarrow \text{نصف ۵} \\ \leftarrow \text{نصف ۶} \end{matrix}$



در این مورد  $T_1 > T_2$  یا  $T_1 < T_2$  است و  $duty\ cycle > 50\%$  است.

زمان  $T_1$  و  $T_2$  برابر است.

اما با وجود  $D$  می توان  $T_1 = T_2$  و  $R_1 = R_2$  انتخاب کرد و  $duty\ cycle = 50\%$  می شود.  
 $R_1 < R_2$  انتخاب کرد و  $duty\ cycle < 50\%$  می شود.  
 $R_1 > R_2$  انتخاب کرد و  $duty\ cycle > 50\%$  می شود.

$T_0 = T_1 + T_2$   
 $f_0 = \frac{1}{T_0}$

مثال) برای رسم سینک  $duty\ cycle = 50\%$  و  $f_0 = 1\ KHz$  فرکانس نویسن.

$T_0 = \frac{1}{f_0} = 1\ msec$  فرکانس نویسن سینک هر یک فرکانس نویسن زمان نویسن انتخاب فرکانس نویسن

چون  $T_1 = T_2 = 1/2\ msec$

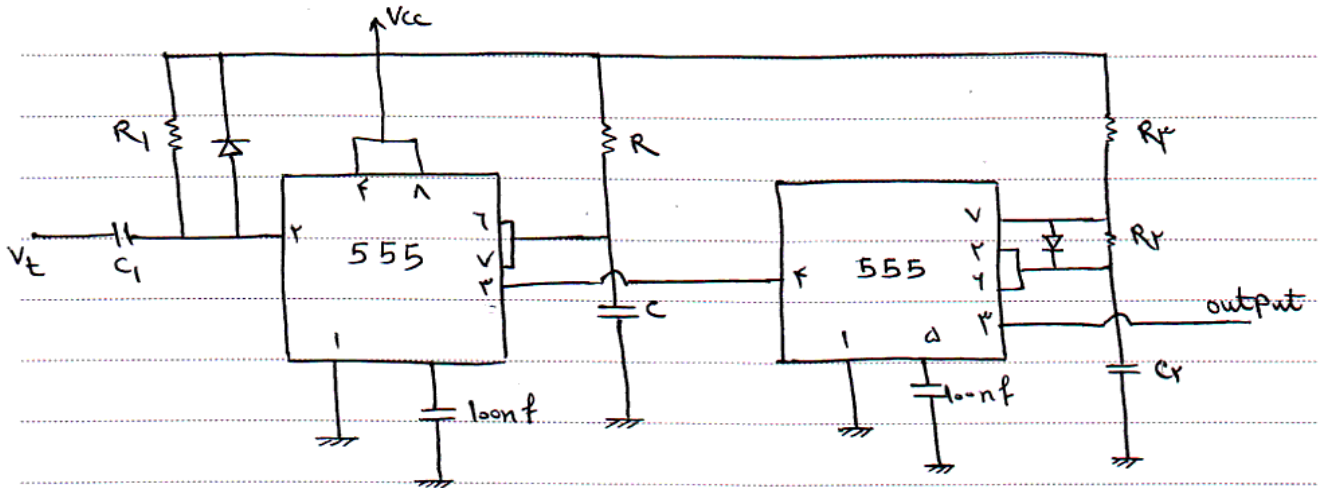
(d.c)  $duty\ cycle = 50\%$   $T_1 = T_2 = 1/2 \times R_1 C = 1/2\ msec$

$C = 10\ nF$  انتخاب فرکانس نویسن  $\Rightarrow R_1 = R_2 = 72\ k\Omega \approx 71\ k\Omega$   $R_1$  و  $R_2$  برابر  $71\ k\Omega$  مقدار زیاد می شود.

مثال) برای رسم سینک در مدت زمان  $10\ msec$  این فرکانس نویسن  $10\ KHz$  (از دود 555 بره)

از یک مولف انتخاب دیت انتخاب استفاده می کنیم چون نویسن خواصیم  $10\ msec$  نویسن نویسن در  $10\ msec$

$duty\ cycle = 50\%$  نویسن نویسن



duty cycle = 50%

$T = 1/RC = 10 \text{ msec}$

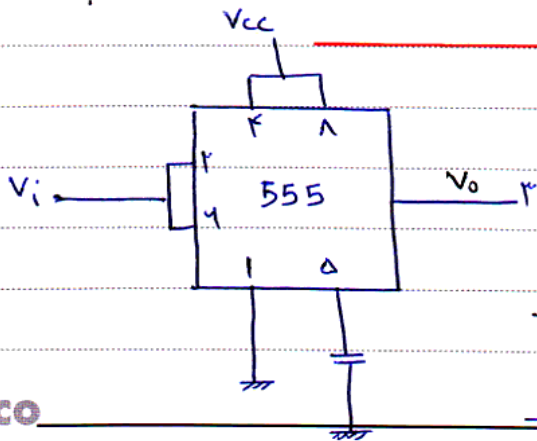
$C = 100 \text{ nf} \rightarrow R = 90 \text{ K}\Omega$

دuty cycle = 50%

$R_1 C_1 < \frac{T}{10} = \frac{10}{10} = 1 \text{ msec} \quad R_1 C_1 < \frac{T_{\text{min}}}{10} = \frac{T}{10}$

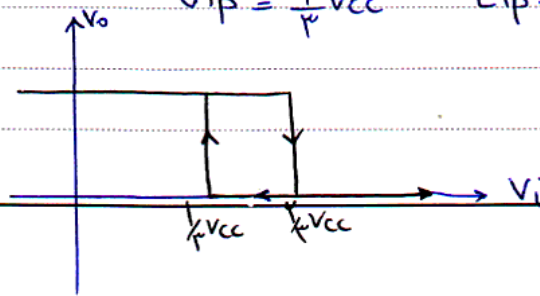
$C_1 = 100 \text{ nf} \rightarrow R_1 = 10 \text{ K}\Omega$

$T_r = T_f = \frac{T_0}{2} = \frac{1 \text{ msec}}{2} = 0.5 \text{ msec} = 1/49 \text{ K}\Omega \text{ C}_2 \rightarrow C_2 = 10 \text{ nf}$   
 $d.c = 50\% \quad R_2 = 10 \text{ K}\Omega = R_f$



این مدار یک مدار استیبل مونو استیبل است

$UT_p = \frac{2}{3} V_{cc} \quad LT_p = \frac{1}{3} V_{cc}$



اگر ورودی کم باشد یک این Reset مدار اعمال می شود چون برای یک می بود اما اگر ورودی از ما بیشتر تا

$\frac{2}{3} V_{cc}$  یک این Reset اعمال می شود و خروجی را می سنوید.

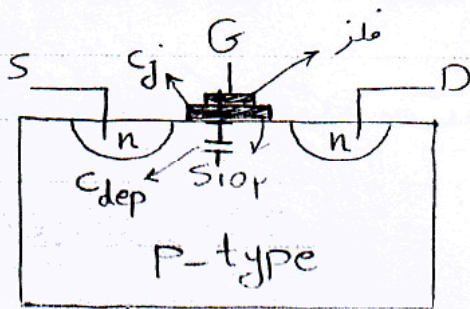
فصل ۴ :

استفاده از گیت های منطقی CMOS در ساخت مدارهای مولتی ویدر انور:

مشخصه های گیت های CMOS:

ساختار گیت های CMOS بر اساس ترانزیستورهای mosfet می باشد.

در ورودی ترانزیستورهای ماسفت یک بار خازنی کوچک وجود دارد.



E-mosfet

ولتاژ آستانه:  $V_t$

با دلیل وجود بار خازنی در ورودی گیت و به واسطه مقاومت ورودی بی نهایت، جریان ورودی

صفر است. مقاومت خروجی آن ها ( $R_o$ ) تقریباً صفر است.

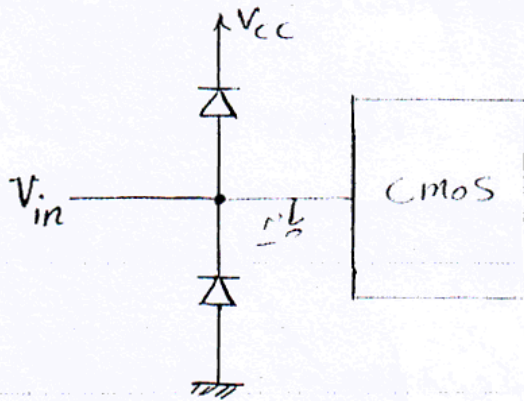
هنگام بار الکتریکی کوچکی ناشی از تماس دست بر روی ورودی گیت (بایه های IC) قرار

گیرد و به علت خازن کوچک ورودی  $V = \frac{q}{C}$  یک ولتاژ بزرگ بر روی گیت قرار می گیرد

که باعث سوختن گیت خواهد شد.



برای حل این مشکل از دیودهای محافظ استفاده می‌شود.  
 ESD Electro static Discharge



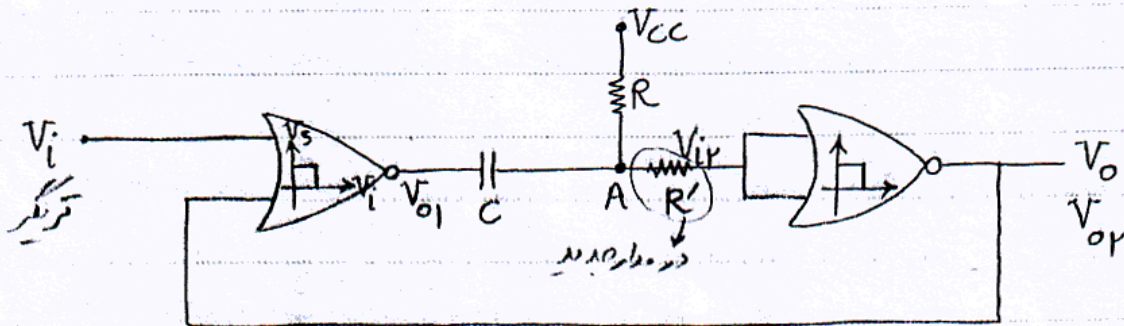
همواره ولتاژ ورودی سن کمتر از  $V_{cc}$  محدود می‌گردد.  
 $0 < V_{in} < V_{cc}$

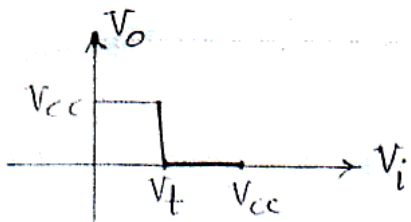
\* سرعت گیت‌های CMOS کم است به علت بارخازنی ورودی و مقاومت داخلی منبع.

تاثير CMOS نسبت به TTL است.  
 Tra.Tra.Logic

انواع گیت‌های CMOS: معمولی / استبداد برتری

مثال) مدار شکل زیر یک مدار مونتو استابل (نشان می‌دهد):





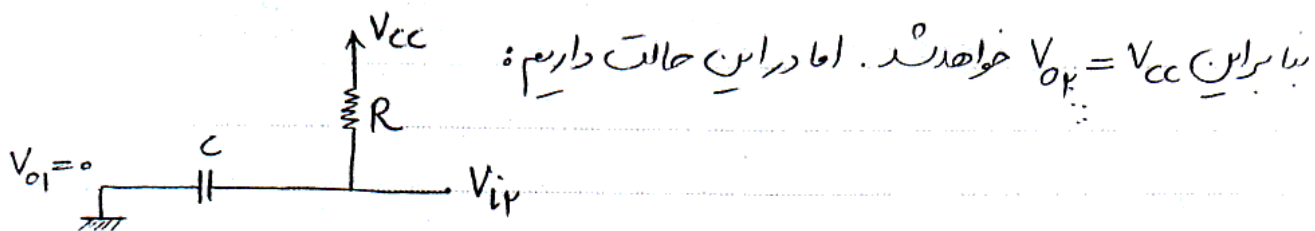
حل) در حالت دائمی خازن C مدار باز می شود و از مدار جدا می گردد.  
 در طول ترنسیز  $V_i = 0$

$$V_{iP} = V_{CC} \rightarrow V_{oP} = V_o = 0 \rightarrow V_{o1} = V_{CC}$$

$$V_C = V_A - V_{o1} = 0 \quad \text{حالت دائمی و پایدار}$$

اما هنگامی که ترنسیز به  $V_i$  اعمال شود  $V_i > V_t \leftarrow V_{o1} = 0$  چون یک طرف خازن C

به اندازه  $V_{CC}$  پر شده منفی می کند طرف دیگر  $V_A$  هم به اندازه  $V_{CC}$  کم می شود. لذا  $V_A < V_t$



یعنی  $V_{iP}$  به صورت تدریجی سار شده با ثابت زمانی RC و نهایتاً می خواهد به  $V_{CC}$  برسد اما

به معنی رسیدن به  $V_t$  ،  $V_{oP} = 0$  خواهد شد. لذا  $V_{i1} = 0$  و  $V_{o1} = V_{CC}$  می شود یعنی

یک طرف خازن C به اندازه  $V_{CC}$  پر شده مثبت می کند اما طرف دیگر جدا شده نمی تواند به  $V_{CC}$

برسد (با فرض وجود مدار محافظ دیودی در ورودی گیت) که این کار  $\Delta V_C \neq 0$  تغییرات

در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ [www.tbi-net.com](http://www.tbi-net.com)

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا